

1. Procedeu de obținere a celulelor fotovoltaice, care include procesele de depunere chimică sau din vapori a peliculelor din impurități pe suprafața plăchetei de semiconductor, de difuzie, de oxidare și depunere a contactelor ohmice, caracterizat prin aceea că procesele difuzia impurităților din diferite surse cu formarea joncțiunilor de tipul $n^+ - p$, sau $p^+ - n$, sau $n^+ - p - p^+$, oxidarea, depunerea contactelor ohmice și depunerea peliculelor antireflectoare se efectuează cu prelucrarea fototermică rapidă.
2. Procedeu de obținere a celulelor fotovoltaice, care include procesele de depunere chimică sau din vapori a peliculelor din impurități pe suprafața plăchetei de semiconductor, de difuzie, de oxidare și depunere a contactelor ohmice, caracterizat prin aceea că pe una sau ambele suprafețe opuse ale plăchetei de semiconductor de tipul „p” sau „n” se depune o sursă de difuzie în formă de peliculă sticloasă dopată cu una din impurități, donor sau acceptor, de exemplu, siliciura de fosfor sau siliciura de bor, prin metoda oxidării anodice sau depunerii chimice în prezența razelor ultraviolete sau în lipsa luminii, după care are loc prelucrarea fototermică rapidă a plăchetei, difuzia impurităților cu formarea joncțiunilor de tipul $n^+ - p$, sau $p^+ - n$, sau $n^+ - p - p^+$, sau $p^+ - n - n^+$ în vid, în aer sau în prezența unui gaz inert, de exemplu, argon, și depunerea peliculelor antireflectoare.
3. Procedeu de obținere a celulelor fotovoltaice, care include procesele de depunere chimică sau din vapori a peliculelor din impurități pe suprafața plăchetei de semiconductor, de difuzie, de oxidare și depunere a contactelor ohmice, caracterizat prin aceea că pe una din suprafețele plăchetei de semiconductor de tipul „p” sau „n” se depune o sursă de difuzie în formă de peliculă sticloasă dopată cu una din impuritățile donor, de exemplu siliciură de fosfor, iar pe suprafața opusă a plăchetei de semiconductor se depune o altă sursă de difuzie de tip acceptor în formă de peliculă metalică, de exemplu, aluminiu, prin metoda evaporării în vid, sau oxidării anodice, sau prin depunerea chimică în prezența razelor ultraviolete sau în lipsa luminii, după care are loc prelucrarea fototermică rapidă a plăchetei, difuzia impurităților cu formarea joncțiunilor de tipul $n^+ - p$, sau $p^+ - n$, sau $n^+ - p - p^+$, sau $p^+ - n - n^+$ în vid, în aer sau în prezența unui gaz inert, de exemplu, argon, și depunerea peliculelor antireflectoare.
4. Procedeu de obținere a celulelor fotovoltaice, care include procesele de depunere chimică sau din vapori a peliculelor din impurități pe suprafața plăchetei de semiconductor, de difuzie, de oxidare și depunere a contactelor ohmice, caracterizat prin aceea că include procese de difuzie a impurităților din diferite surse cu formarea joncțiunilor conform revendicărilor 1, 2 sau 3, apoi, după curățirea suprafeței plăchetei, are loc depunerea contactelor ohmice de metal, de exemplu, Al sau Ni, sau Cu, sau pasta de Ag, sau contacte ohmice străvezii de InSnO , urmate de prelucrarea fototermică rapidă în vid, în aer sau în camera cu gaze inerte, de exemplu, cu argon, și depunerea peliculelor antireflectoare.
5. Procedeu de obținere a celulelor fotovoltaice, care include procesele de depunere chimică sau din vapori a peliculelor din impurități pe suprafața plăchetei de semiconductor, de difuzie, de oxidare și depunere a contactelor ohmice, caracterizat prin aceea că include procese de difuzie a impurităților din diferite surse cu formarea joncțiunilor și depunerea contactelor ohmice conform revendicărilor 1, 2, 3, sau 4, după care are loc depunerea peliculei străvezii cu proprietăți de antireflector din oxid metalic, de exemplu, ZnO_2 sau TiO_2 , urmată de prelucrarea fototermică rapidă în vid, în aer sau în camera cu gaze, de exemplu, cu oxigen, și depunerea peliculelor antireflectoare.